




FACULTY OF PHYSICS AND MATHEMATICS

	<p>NAME: Ismoilov Shavkat Qo'ziyevich</p> <p>POSITION: associate professor</p> <p>TEL: +998999617524</p> <p>E – mail: shavkat6819@mail.ru</p> <p>ORGANISATION TEL: +99862 2246700</p> <p>ORGANISATION ADDRESS: Urgench, Kh.Olimjan str, 14, 220100</p>
<p>EDUCATION:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1985 - 1990 - TashSU, Faculty of Physics, student; • 1981 –1992 - Institute of Mathematics UzFA, trainee researcher; • 1998 - 2001 - Institute of Physics and Technology UzFA, graduate student
<p>CAREER / EMPLOYMENT:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1993 - 1998 - UrSU, trainee teacher, • 2001 - 2008 - Urgench State University, assistant, • 2008 - present - Associate Professor of "Physics" Urgench State University.
<p>SPECIALITY</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Physics of semiconductors and dielectrics.
<p>TEACHING SUBJECTS:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thermodynamics and static physics, Theoretical mechanics, Molecular physics, Microelectronics
<p>RESEARCH AREAS OF INTEREST:</p>	<p>Выращивание и исследование электронных и оптических свойств твердых растворов $(Ge_2)_{1-x}(InP)_x (0 \leq x \leq 1)$</p>
<p>PRESENT PROJECTS:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выращивание кристаллические совершенных Si – SiGe–(Ge)_{1-x}(InP)_x структур из жидкой фазы. Письма в ЖТФ, 1999, том 25, вып. 24, стр. 37-40. 2. Токопрохождение в pSi_{1-x} – Ge_x – n(Ge₂)_{1-x} (InP)_x структурах. ДАН РУз. Ташкент, 2005, № 2 стр. 23-25. 3. Optical Properties of (Ge₂)_{1-x}(InP)_x Solid Solution. Technical Physics Letters, 2006, vol. 32, № 6. pp. 538-541. 4. Электронная структура твердого раствора (Ge₂)_{1-x}(InP)_x, УФЖ, Ташкент, 2006, № 6. УФЖ, Ташкент, 2006, № 6. 5. Оптические свойства твердого раствора (Ge₂)_{1-x}(InP)_x. Письма в ЖТФ 2006, т. 32, вып 12, 63-70 стр 6. Электронная структура твердого раствора (Ge₂)_{1-x}(InP)_x. // УзФЖ, Ташкент, 2007, № 1. 7. Прогноз процессов льдаобразования в водных ресурсах Хорезмского оазиса. Илм сарчашмалари 2011, 9-сон, 56-58 б. 8. Киришмаларнинг кристалл музда эрувчанлигига масаласига доир. Илм сарчашмалари журнали 2012 й. N 2 9. Выращивание эпитаксиальных слоев (Sn₂)_x(InSb)_{1-x} на GaAs подложке из жидкой фазы. Илм сарчашмалари журнали, 2016 г. №8 10. Яримўтказгичлар ва диэлектриклар физикаси фанидан электрон ўқув модули ишланмасини яратиш. Илм сарчашмалари 2016 й. № 12 11. Simulation of parametrs of nGe-pSiGe diode structures on TCAD SENTAURUS. “Actual problems modern science education end training in the region” Electronic scientific

	<p>edited volume 1. 2017 42-46 p.</p> <p>12. Жидкофазная эпитаксия твердых растворов $(Ge_2)_{1-x}(InP)_x$ и $(GaAs)_{1-x-y}(Ge_2)(ZnSe)_y$. “Технологии Техника Инженерия” Международный научный журнал № 2.1 (4.1) / 2017 г., стр.28-30</p> <p>13. О зонной структуре твердого раствора $Ge_{1-x}Sn_x$. Образования и воспитания, Международный научный журнал № 3.1 (18.1) / 2018 г., стр. 24-</p>
<p>LIST OF SELECTED PAPERS</p>	<p>1. Выращивание эпитаксиальных слоев $(Sn_2)_x(InSb)_{1-x}$ на <i>GaAs</i> подложке из жидкой фазы. Илм сарчашмалари журналы, 2016 г. №8</p> <p>2. Яримўтказгичлар ва диэлектриклар физикаси фанидан электрон ўқув модули ишланмасини яратиш. Илм сарчашмалари 2016 й. № 12</p> <p>3. Simulation of parametrs of nGe-pSiGe diode structures on TCAD SENTAURUS. “Actual problems modern science education end training in the region” Electronic scientific edited volume 1. 2017 42-46 p.</p> <p>4. Жидкофазная эпитаксия твердых растворов $(Ge_2)_{1-x}(InP)_x$ и $(GaAs)_{1-x-y}(Ge_2)(ZnSe)_y$. “Технологии Техника Инженерия” Международный научный журнал № 2.1 (4.1) / 2017 г., стр.28-30</p> <p>5. О зонной структуре твердого раствора $Ge_{1-x}Sn_x$. Образования и воспитания, Международный научный журнал № 3.1 (18.1) / 2018 г.</p>